

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108  
г. Астана, ул. Ауэзова, 33/1, офис 210

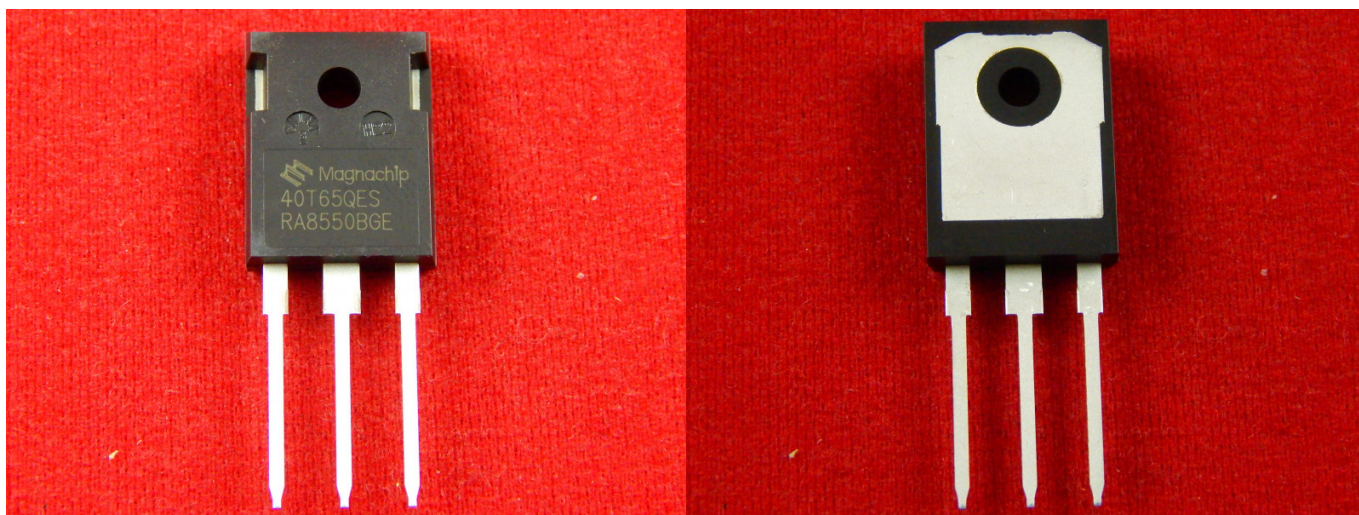
E-Mail: [support@radiomart.org](mailto:support@radiomart.org)



**Артикул: 17811**

**Цена в прайсе: 1078 тг.**

**MBQ40T65QES, Транзистор IGBT, N-канал, 650В, 80А, TO-247**



Транзистор – полупроводниковый элемент с тремя выводами (обычно), на один из которых (коллектор) подаётся сильный ток, а на другой (база) подаётся слабый (управляющий ток).

IGBT транзистор - это довольно хитроумный прибор, который представляет собой гибрид полевого и биполярного транзистора. Данное сочетание привело к тому, что он унаследовал положительные качества, как полевого транзистора, так и биполярного.

#### **Спецификация:**

- Тип транзистора: IGBT;
- Маркировка: 40T65QES;
- Тип управляющего канала: N;
- Максимальная рассеиваемая мощность ( $P_c$ ), Вт: 230;
- Предельно-допустимое напряжение коллектор-эмиттер  $|V_{ce}|$ , В: 650;
- Максимально допустимое напряжение эмиттер-затвор  $|V_{ge}|$ , В: 20;
- Максимальный постоянный ток коллектора  $|I_c|$  @25°C, А: 80;
- Напряжение насыщения коллектор-эмиттер типовое  $|V_{CE(sat)}|$ , В: 1.8;
- Максимальное пороговое напряжение затвор-эмиттер  $|V_{GE(th)}|$ , В: 6.5;
- Максимальная температура перехода ( $T_j$ ), °C: 150;
- Время нарастания типовое ( $t_r$ ), nS: 36;
- Емкость коллектора типовая ( $C_c$ ), pF: 120;
- Общий заряд затвора ( $Q_g$ ), typ, nC: 60;
- Тип корпуса: TO247.